

半导体学报

第6卷 第6期 1985年11月

目 录

- 强磁场下 n 型 InSb 杂质带及其电导的理论黄 敏 韩汝琦 甘子钊 (563)
- Gilbert 乘法器的三次非线性误差易明铤 李青松 (576)
- 高剂量低能氧离子注入硅形成 SiO₂ 薄膜的研究王 勇 李维中 李志坚 (584)
- 双异质结半导体激光器在阶跃和正弦电流调制下的行为王守武 王仲明 (590)
- CMOS 门阵列的一种布线方法张钦海 唐璞山 (602)
- 双极型功率晶体管的温度分布和直流安全工作区曾庆明 (611)
- 脉冲激光诱导扩散的计算机模拟刘 焜 谢宗钧 黄乐斌 (620)
- Sigmund 元素溅射率公式的修正陈国樑 (627)
- Ga_{1-x}Al_xAs 和 GaAs_{1-x}P_x 混晶的长波长光学声子谱汪兆平 韩和相 赵学恕 李国华 涂相征 (634)
- 高浓度注砷和注铋硅的连续氩离子激光退火研究钱佩信 林惠旺 陆永枫 李冬梅 (641)
- 电子俘获对 φ_b 和热电子流的影响李肇基 (648)

研 究 简 报

- 氢化非晶硅液相激光结晶鲍希茂 杨 敏 (655)
- 利用 $I-V$ 特性确定 Schottky 势垒中的准费米能级葛惟锬 (658)

研 究 快 报

- 大光腔分段压缩-平面复合腔激光器杜国同 高鼎三 杨德林 (661)